

Облікова картка ДіР



I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0218U002310

Державний реєстраційний номер: 0117U002931

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 14-02-2018

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Етап 2017 року

Початок етапу: 03.2017

Закінчення етапу: 12.2017

Вид звітного документа: Проміжний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова Національної академії наук України

Код за ЄДРПОУ: 05416952

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 525-62-96 , 525-62-96

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Національна академія наук України

Код за ЄДРПОУ: 00019270

Місцезнаходження: вул. Володимирська, 54, м. Київ, Київська обл., 01030, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380442396594

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрямок фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 6541030

Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.): 985
--

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

ІФН-2017/3

Назва роботи англійською:

ІФН-2017/3

Реферат українською:

-

Реферат англійською:

-

Індекс УДК: 654.9:621.3.029.71/.73; 654.9:621.384, 621.384.3

Коди тематичних рубрик: 47.57.29

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Беляєв Олександр Євгенович

Науковий ступінь: д. ф.-м. н.

Вчене звання: професор, акад.

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

Назва НТП українською: Науково-технічний звіт про виконання етапу 2017 року

Назва НТП англійською: Scientific and technical report on the implementation of the 2017 phase

НТП, яку передбачалося створити:

Причини, через які НТП не було створено:

Отримані результати:

Галузь застосування: ...

Реєстраційний номер картки технології:

Опис НТП: -

Соціально-економічна спрямованість НТП:

Вплив НТП на довкілля:

Впровадження НТП: Не впроваджено

Практична реалізація НТП

Початок етапу: -

Закінчення етапу:

Споживачі продукції: Міністерство оборони України

Перспективні ринки: Україна

Характер співробітництва з інвестором

Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:

Права, що надаються інвестору після завершення роботи:

Наявність бізнес-плану:

Техніко-економічне обґрунтування:

Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:

Очікуваний термін окупності (років):

Додаткова інформація:

IX. Бібліографічний опис

1. Michael Kinch. Fundamentals of Infrared Detector Materials - Bellingham, Washington: SPIE Press, 2007.- 173 p.
2. Сизов Ф.Ф. Фотоелектроника для систем видения - Киев: Академперіодика, 2008.- 455 с. [Photoelectronics for imaging systems. Kyiv, Akademperiodyka, 2008, 455 p. (Rus)].
3. MCT's Advantages as an Infrared Imaging Material. http://www.leonardodrs.com/media/4279/201306_advantages_of_mct.pdf
4. Peter Capper, James Garland. Mercury Cadmium Telluride: Growth, Properties and Applications - Wiley and Sons, 2011.
5. Филачев А.М., Таубкин И.И., Тришенков М.А. Современное состояние и магистральные направления развития твердотельной фотоэлектроники - Москва: Физматкнига, 2010. - 125 с. [Current state and main directions of development of solid-state photoelectronics. Moskow, Phizmatkniga, 2010, 125 p. (Rus)].
6. Сизов Ф.Ф. ИК-фотоэлектроника: фотонные или тепловые детекторы? Перспективы // СЕМСТ - 2015.- Т. 12, №1.- С. 26 - 52

[Sizov F. IR-photoelectronics: photon or thermal detectors? Outlooks, 2015, vol. 12, iss. 1, pp. 26-52]. 7. J.T. Wimmers, R.M. Davis, C.A. Niblack, D.S. Smith. Indium antimonide detector technology at Cincinnati Electronics Corporation // Proc. SPIE - 1988.- vol. 930.- pp.125-138. 8.Ф.Ф. Сизов, Г.О. Гузенко, И.А. Лисюк, К.В. Андреева. Зондова установка для вимірювання електрофізичних характеристик напівпровідникових структур при криогенних температурах. Патент на корисну модель № 19435 U, МПК G01R 1/00, бюлетень №12/2006. 9.Зи. Физика полупроводниковых приборов, т.2, стр. 350. 10.J. Chu and A. Sher. Physics and properties of narrow-gap semiconductors - Springer, N.Y., 2008.- 606 p. 11.L.N. Kurbatov. Optoelektronika vidimogo i infrakrasnogo diapasonov spektra. MFTI, M. 320 s. (1999). 12.Holst G.C. Electro-optical imaging systems performance. SPIE Optical Eng. Press, Bellingham, USA, 442 p. (2003).

Х. Заключение відомості

Керівник юридичної особи

Беляев Олександр Євгенович

д. ф.-м. н., 01.04.10

Перелік осіб-виконавців

Андреева Катерина Вікторівна

Вуйчик Микола В'ячеславович

Голенков Олександр Геннадійович

Забудський Вячеслав Володимирович

Мележик Євген Олександрович

Свеженцова Катерина Віталіївна

Сизов Федір Федорович

Цибрій Зіновія Федорівна

Відповідальний за підготовку

облікових документів

Телефон

Реєстратор

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності**

